

	<h2 style="color: red;">IPB067N08N3 G</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">IPB067N08N3 G</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies)</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	IPB067N08N3 G Infineon Technologies
<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">IPB067N08N3 G.pdf</a>	
<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform	
<b>Lagerzustand:</b>	New original, 27800 pcs Stock Available.	
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong	
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">IPB067N08N3 G</a>
Hersteller	<a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies)</a>
Beschreibung	IPB067N08N3 G Infineon Technologies
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	27800 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.5V @ 73µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO263-2
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	6.7 mOhm @ 73A, 10V
Verlustleistung (max)	136W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D <sup>2</sup> Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3840pF @ 40V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	56nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	6V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	80V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	80A (Tc)


IPB067N08N3 G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPB067N08N3 G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPB067N08N3 G International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ IPB067N08N3 G E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

sein:



**IPB06CN10N G**  
Infineon Technologies  
MOSFET N-CH 100V 100A TO263-3



**IPB06CN10NG**  
INF  
IPB06CN10NG INF



**IPB065N15N3G**  
INFINEON  
IPB065N15N3G INFINEON



**IPB065N15N3**  
INFINEON  
IPB065N15N3 INFINEON



**IPB06CNE8NG**  
VB  
IPB06CNE8NG VB



**IPB065N15N3 G**  
Infineon Technologies  
IPB065N15N3 G Infineon Technologies



**IPB065N15N3GATMA1**  
International Rectifier (Infineon Technologies)  
MOSFET N-CH 150V 130A TO263-7



**IPB067N08N3GATMA1**  
International Rectifier (Infineon Technologies)  
MOSFET N-CH 80V 80A TO263-3

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

[IPB067N08N3 G International Rectifier](#) [IPB067N08N3 G Datenblatt](#) (Infineon Technologies)

[IPB067N08N3 G-Datenblätter](#)

[IPB067N08N3 G PDF](#)

[International Rectifier \(Infineon Technologies\) IPB067N08N3 G](#)

[IPB067N08N3 G Electronic](#)

[IPB067N08N3 G-Komponenten](#)

[IPB067N08N3 G-Verteiler](#)

[IPB067N08N3 G-Bild](#)

[IPB067N08N3 G-Teil](#)

[IPB067N08N3 G Preis](#)

[IPB067N08N3 G Hersteller](#)

[IPB067N08N3 G Bild](#)

[IPB067N08N3 G Aktie](#)

[IPB067N08N3 G Inventar](#)

[IPB067N08N3 G Neu](#)

[IPB067N08N3 G Original](#)

[IPB067N08N3 G garantiert](#)

[IPB067N08N3 G RFQ](#)

[IPB067N08N3 G Online bestellen](#)

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited